

	<h2>SI6473DQ-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI6473DQ-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP</p> <p>Datenblätter:  SI6473DQ-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

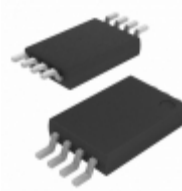


Spezifikationen

Teilenummer	SI6473DQ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 250µA (Min)
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12.5 mOhm @ 9.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.08W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 6.2A (Ta) 1.08W (Ta) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.2A (Ta)

SI6473DQ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI6473DQ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI6473DQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI6473DQ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI6473DQ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP</p>	 <p>SI6473DQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP</p>	 <p>SI6475DQ V SI6475DQ V</p>	 <p>SI6469DQ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 8V 8TSSOP</p>
 <p>SI6473DQ-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP</p>	 <p>SI65-2R7L ACCEPTE</p>	 <p>SI6542DQ-T1 SI SI6542DQ-T1 SI</p>	 <p>SI6469DQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 8TSSOP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI6473DQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI6473DQ-T1-GE3 Datenblatt	SI6473DQ-T1-GE3-Datenblätter	SI6473DQ-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI6473DQ-T1-GE3
SI6473DQ-T1-GE3 Electronic	SI6473DQ-T1-GE3-Komponenten	SI6473DQ-T1-GE3-Verteiler	SI6473DQ-T1-GE3-Bild	SI6473DQ-T1-GE3-Teil
SI6473DQ-T1-GE3 Preis	SI6473DQ-T1-GE3 Hersteller	SI6473DQ-T1-GE3 Bild	SI6473DQ-T1-GE3 Aktie	SI6473DQ-T1-GE3 Inventar
SI6473DQ-T1-GE3 Neu	SI6473DQ-T1-GE3 Original	SI6473DQ-T1-GE3 garantiert	SI6473DQ-T1-GE3 RFQ	SI6473DQ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited